

2018年6月12日
一般社団法人 新金属協会
化合物半導体部会
部会長 山田 雅人
信越半導体株式会社
化合物半導体部 部長

平成 29 年度通期の化合物半導体の出荷統計について

2017 年度通期（2017 年 4 月～2018 年 3 月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2017 年度通期（2017 年 4 月～2018 年 3 月）の化合物半導体製品の出荷額は、283 億円となりました。結晶別では、主要 3 品目のすべてで増加致しました。用途別でも LD、可視 LED、赤外 LED、その他のすべてで増加致しました。

1.GaAs

2017 年度通期の GaAs の売上高は、185 億円となり、国内、海外ともに増加しました。GaAs の主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外 LED、および光ディスク・加工機・センサ等に使用されるレーザダイオード(LD)等がありますが、2017 年度の結果は国内外の多くの用途で、需要が増大したことによると推察しています。

2.GaP

2017 年度通期の GaP の売上高は、25 億円となり、国内、海外ともに増加しました。可視 LED 用途市場の需要落ち込みの影響や GaP 系および GaAsP 系 LED が車載、家電等の特定市場へ絞り込まれていく傾向は続いているものの、高輝度 AlInGaP 系や GaN 系 LED への置き換えのスピードがやや緩やかになり堅調に推移した結果と推察しています。

3.InP

2017 年度通期の InP の売上高は、61 億円となり、国内は減少したものの、海外は増加し、全体としては増加となりました。InP の主要な用途である光通信用の受発光素子の需要が引き続き堅調に推移した結果と推察しています。

<お問い合わせ先>
化合物半導体部 担当部長
小原 正義
電話 027-385-2970 Fax 027-385-2773
e-mail : m-obara@seh.jp